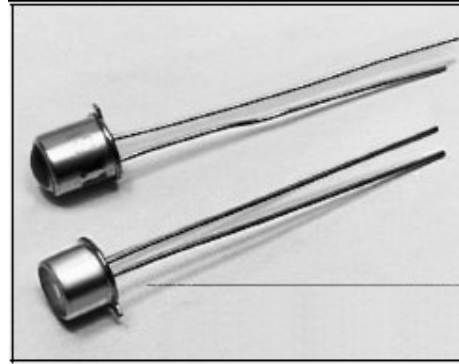


SE3470/5470

AlGaAs 红外线发射二极管

特点:

- TO-46 金属壳封装件
- 可选择平光视窗或有透镜的封装件
- 具有 90°或 20°(额定) 光束角选项
- 880nm 的波长
- 在等效驱动电流下功率输出较 GaAs 更大
- 宽工作温度范围 (-55°C 至+125°C)
- 适用于高脉冲电流
- 可与 SD3421 / 5421 光电二极管, SD3443 / 5443 / 5491 光电晶体管, SD3410 / 5410 光敏达林顿放大器 SD5600 系列双稳态电路触发器机械和光谱匹配。



INFRA-83.TIF

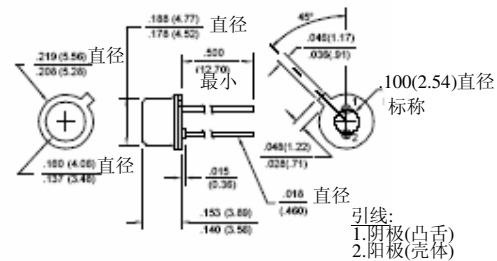
描述:

SE3470/5443 系列由一铝砷化镓红外线发射二极管组成, 都可被安装在 TO-46 金属罐封装件内。SE3470 系列有平光视窗提供宽范围接收角度, SE5470 同时也有玻璃透镜提供窄范围光束角。TO-46 封装件具有高功耗容量并可完美地适用于在恶劣环境下进行操作。

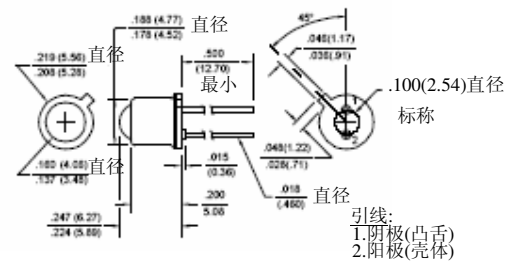
外形尺寸: 英寸 (mm)

公差: 3 plc decimals ± 0.005 (0.12)
2 plc decimals ± 0.020 (0.51)

SE3470



SE5470



电气特性 (无其他说明时, 为 25°C)

参数	符号	最小值	标准值	最大值	单位	测试条件
总功率输出 ⁽¹⁾	P _O				mA	I _F =100mA
SE3470-001		7.0				
SE3472-002		9.0				
SE3470-003		10.5				
SE5470-001		7.0				
发光 ⁽²⁾	H				mW/cm ²	I _F =100mA
SE5470-002		1.5				
SE5470-003		2.6		5.9		
SE5470-004		3.5				
正向电压	V _F			1.9	V	I _F =100mA
反向击穿电压	V _{BR}	3.0			V	I _R =10μA
峰值输出波长	λ _p		880		nm	
光谱带宽	Δλ		80		nm	
光谱随温度漂移	Δλ _p /ΔT		0.2		nm/°C	
光束角 ⁽³⁾	Φ				°(度)	I _F =常量
SE3470			90			
SE3472			20			
辐射上升和下降时间	t _r , t _f		0.7		μs	

注:

1. 封装件发出的总发射功率(mW)。
2. 进入 0.25(6.35) 光圈的测量值, 光圈被安置在距镜头顶端 1.20(30.5)处。
3. 光束角的定义是指包括在半光束强度点之间的总的角度。

绝对最大额定值

(无其他说明时, 大气温度为 25°C)

持续正向电流	100mA
峰值正向电流	3A
(1μs 脉冲宽, 300 pps)	150 mW ⁽¹⁾
功耗	-55°C 至 125°C
工作温度范围	-65°C 至 150°C
储存温度范围	260°C
焊接温度(10 秒)	

注:

1. 从大气温度为 25°C 起以 1.43 mW/°C 的比率呈线性递减。

示意图

阳极



阴极

图1 辐射强度与角度偏置(SE3470)的关系

gra_017.ds4

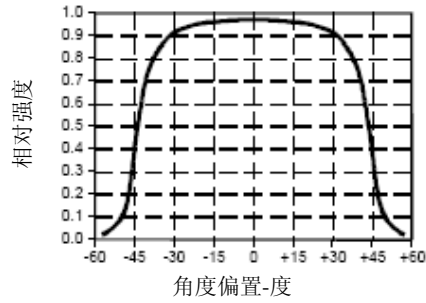


图2. 辐射强度与角度偏置(SE5470)的关系

gra_023.ds4

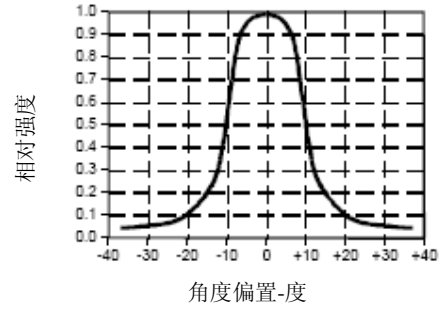


图3. 辐射强度与正向电流的关系

gra_018.cdr

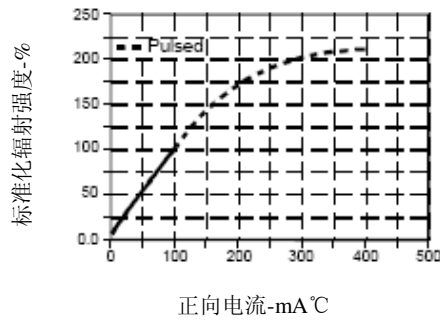


图4. 正向电压与正向电流的关系

gra_026.ds4

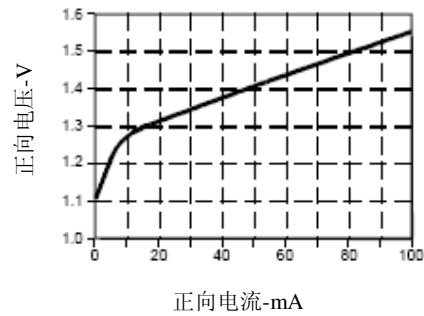


图5. 正向电压与温度的关系

gra_025.ds4

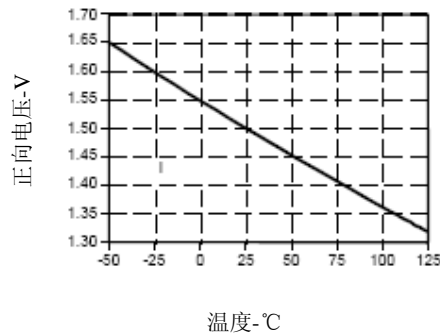


图6. 带有 SD3443 的耦合特性 SE3470

gra_021.ds4

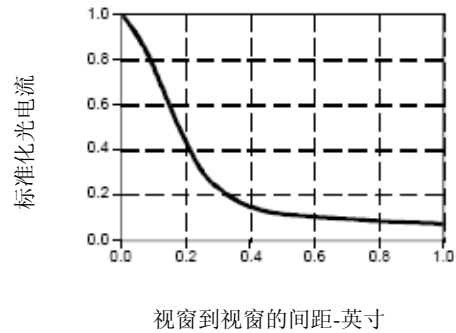


图 7. 光谱响应度

gra_011.ds4

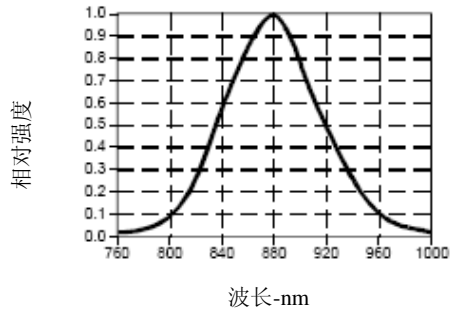


图 8. 辐射强度与壳体温度的关系

gra_022.ds4

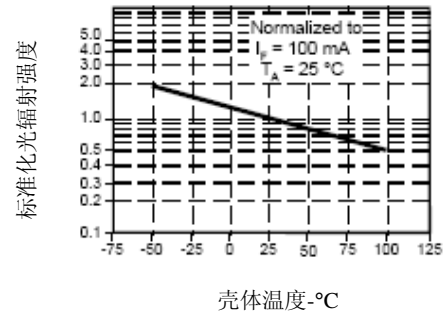
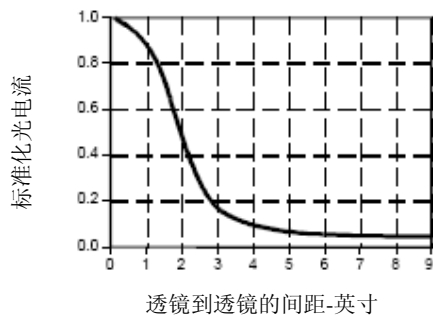


图 9. 带有 SD5443 的耦合特性 SE5470

gra_024.ds4



所有性能曲线表示标准值